

## PNP 中功率放大三极管 Medium Power Transistor(PNP)

### Medium Power Transistor(PNP)

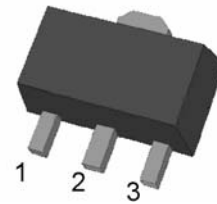
### PNP 中功率放大三极管

### FHB1132

#### DESCRIPTION & FEATURES 概述及特点

- 1) Low  $V_{CE(sat)} = -0.2V(Typ)$   
( $I_C / I_B = -500mA / -50mA$ )
- 2) Complements the FHD1664
- 3) Epitaxial planar type,  
PNP silicon transistor

SOT-89



#### PIN ASSIGNMENT 引脚说明

PIN NAME 管脚符号	PIN NUMBER 引脚序号	FUNCTION 功能
	SOT-89	
B	1	BASE
C	2	COLLECTOR
E	3	EMITTER

#### MAXIMUM RATINGS( $T_a=25^\circ C$ ) 最大额定值

CHARACTERISTIC 特性参数	Symbol 符号	Rating 额定值	Unit 单位
Collector-Emitter Voltage 集电极-发射极电压	$V_{CEO}$	-32	Vdc
Collector-Base Voltage 集电极-基极电压	$V_{CBO}$	-40	Vdc
Emitter-Base Voltage 发射极-基极电压	$V_{EBO}$	-5	Vdc
Collector Current(DC)集电极电流-直流	$I_C$	-1	Adc
Collector Current(Pulse)集电极电流-脉冲	$I_{CP}$	-2	Adc

#### THERMAL CHARACTERISTICS 热特性

CHARACTERISTIC 特性参数	Symbol 符号	Max 最大值	Unit 单位
Collector Power Dissipation 集电极耗散功率	$P_c$	500	mW
Junction and Storage Temperature 结温和储存温度	$T_J$ $T_{stg}$	150, -55 ~ 150	$^\circ C$

#### DEVICE MARKING 打标

FHB1132P=BAP(82~180), FHB1132Q=BAQ(120~270), FHB1132R=BAR(180~390)

#### ELECTRICAL CHARACTERISTICS 电特性

( $T_a=25^\circ C$  unless otherwise noted 如無特殊说明, 温度为  $25^\circ C$ )

Characteristic 特性参数	Symbol 符号	Test Condition 测试条件	Min 最小值	Type 典型值	Max 最大值	Unit 单位
Collector-Emitter Breakdown Voltage 集电极-发射极击穿电压	$V_{(BR)CEO}$	$I_C=-1.0mA$	-32	—	—	V
Collector-Base Breakdown Voltage 集电极-基极击穿电压	$V_{(BR)CBO}$	$I_C=-50\mu A$	-40	—	—	V
Emitter-Base Breakdown Voltage 发射极-基极击穿电压	$V_{(BR)EBO}$	$I_E=-50\mu A$	-5.0	—	—	V
Collector Cutoff Current 集电极截止电流	$I_{CBO}$	$V_{CB}=-20V$	—	—	-500	nA
Emitter Cutoff Current 发射极截止电流	$I_{EBO}$	$V_{EB}=-4V$	—	—	-500	nA
DC Current Gain 直流电流增益	$h_{FE}$	$V_{CE}=-3V, I_C=-100mA$	82	—	390	
Collector-Emitter Saturation Voltage 集电极-发射极饱和压降	$V_{CE(sat)}$	$I_C=-500mA, I_B=-50mA$	—	-0.2	-0.5	V
Transition Frequency 特征频率	$f_T$	$V_{CE}=-5V, I_E=-50mA,$ $f = 30 MHz$	—	150	—	MHz
Collect Output Capacitance 输出电容	$C_{Ob}$	$V_{CB}=-10V, I_E=0, f=1MHz$	—	20	30	pF